

ГОСТ 2.730—73

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ
ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ**

ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

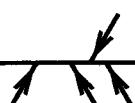
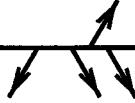
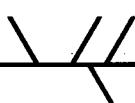
Единая система конструкторской документации**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ****ГОСТ
2.730—73****Приборы полупроводниковые**Unified system for design documentation. Graphical symbols in diagrams.
Semiconductor devicesМКС 01.080.40
31.080**Дата введения 01.07.74**

1. Настоящий стандарт устанавливает правила построения условных графических обозначений полупроводниковых приборов на схемах, выполняемых вручную или автоматическим способом во всех отраслях промышленности.

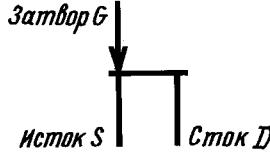
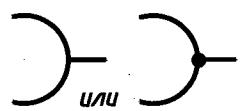
(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Обозначения элементов полупроводниковых приборов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. (Исключен, Изм. № 2).		3. Области:	
2. Электроды: база с одним выводом		область между проводниковыми слоями с различной электропроводностью.	
база с двумя выводами		Переход от P-области к N-области и наоборот	
P-эмиттер с N-областью		область собственной электропроводности (I-область):	
N-эмиттер с P-областью		1) между областями с электропроводностью разного типа PIN или NIP	
несколько P-эмиттеров с N-областью		2) между областями с электропроводностью одного типа PIP или NIN	
несколько N-эмиттеров с P-областью		3) между коллектором и областью с противоположной электропроводностью PIN или NIP	
коллектор с базой		4) между коллектором и областью с электропроводностью того же типа PIP или NIN	
несколько коллекторов, например, четыре коллектора на базе		4. Канал проводимости для полевых транзисторов: обогащенного типа	
		обедненного типа	

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
5. Переход PN		10. Исток и сток П р и м е ч а н и е. Линия истока должна быть изображена на продолжении линии затвора, например:	  
6. Переход NP		11. Выходы полупроводниковых приборов: электрически не соединенные с корпусом	 
7. P -канал на подложке N -типа, обогащенный тип		электрически соединенные с корпусом	
8. N -канал на подложке P -типа, обедненный тип		12. Вывод корпуса внешний. Допускается в месте присоединения к корпусу помещать точку	
9. Затвор изолированный			

61

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3, 4. (Исключены, Изм. № 1).

5. Знаки, характеризующие физические свойства полупроводниковых приборов, приведены в табл. 4.

* Таблицы 2, 3. (Исключены, Изм. № 1).

Таблица 4

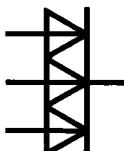
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Эффект туннельный а) прямой	Г	2. Эффект лавинного пробоя: а) односторонний	Г
б) обращенный	И	б) двухсторонний 3—8. (Исключены, Изд. № 2). 9. Эффект Шоттки	Г Г

6. Примеры построения обозначений полупроводниковых диодов приведены в табл. 5.

Таблица 5

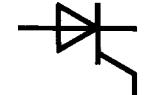
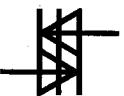
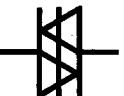
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Диод Общее обозначение	不分	6. Варикап (диод емкостной)	不分 или不分
2. Диод туннельный	不分	7. Диод двунаправленный	不分 или不分
3. Диод обращенный	不分	8. Модуль с несколькими (например, тремя) одинаковыми диодами с общим анодным и самостоятельными катодными выводами	不分
4. Стабилитрон (диод лавинный выпрямительный) а) односторонний	不分		
б) двухсторонний	不分		
5. Диод теплоэлектрический	不分		

Продолжение табл. 5

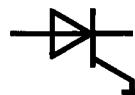
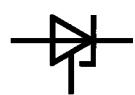
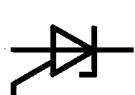
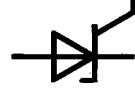
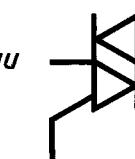
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
8а. Модуль с несколькими одинаковыми диодами с общим катодным и самостоятельными анодными выводами		9. Диод Шотки	
		10. Диод светоизлучающий	

7. Обозначения тиристоров приведены в табл. 6.

Таблица 6

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
63 1. Тиристор диодный, запираемый в обратном направлении		5. Тиристор триодный, запираемый в обратном направлении с управлением:	
2. Тиристор диодный, проводящий в обратном направлении		по аноду	
3. Тиристор диодный симметрический	 или 	по катоду	
4. Тиристор триодный. Общее обозначение		6. Тиристор триодный выключаемый: общее обозначение	
		запираемый в обратном направлении, с управлением по аноду	

Продолжение табл. 6

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
запираемый в обратном направлении, с управлением по катоду 7. Тиристор триодный, проводящий в обратном направлении: общее обозначение	   	8. Тиристор триодный симметричный (двунаправленный) — триак	 или 
с управлением по аноду		9. Тиристор тетроидный, запираемый в обратном направлении	
с управлением по катоду			

П р и м е ч а н и е. Допускается обозначение тиристора с управлением по аноду изображать в виде продолжения соответствующей стороны треугольника.

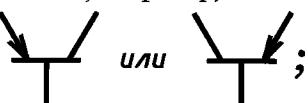
8. Примеры построения обозначений транзисторов с $P-N$ -переходами приведены в табл. 7.

Т а б л и ц а 7

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Транзистор а) типа <i>PNP</i>		5. Транзистор однопереходный с <i>P</i> -базой	
б) типа <i>NPN</i> с выводом от внутреннего экрана		6. Транзистор двухбазовый типа <i>NPN</i>	
2. Транзистор типа <i>NPN</i> , коллектор соединен с корпусом		7. Транзистор двухбазовый типа <i>PNIP</i> с выводом от <i>i</i> -области	
3. Транзистор лавинный типа <i>NPN</i>		8. Транзистор двухбазовый типа <i>PNIP</i> с выводом от <i>i</i> -области	
4. Транзистор однопереходный с <i>N</i> -базой		9. Транзистор многоэмиттерный типа <i>NPN</i>	

П р и м е ч а н и е. При выполнении схем допускается:

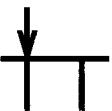
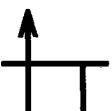
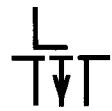
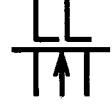
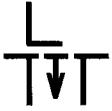
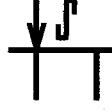
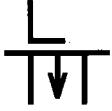
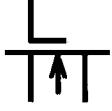
а) выполнять обозначения транзисторов в зеркальном изображении, например,



б) изображать корпус транзистора.

9. Примеры построения обозначений полевых транзисторов приведены в табл. 8.

Т а б л и ц а 8

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Транзистор полевой с каналом типа <i>N</i>		4. Транзистор полевой с изолированным затвором обогащенного типа с <i>N</i> -каналом, с внутренним соединением истока и подложки	
2. Транзистор полевой с каналом типа <i>P</i>		5. Транзистор полевой с изолированным затвором с выводом от подложки обогащенного типа с <i>P</i> -каналом	
3. Транзистор полевой с изолированным затвором без вывода от подложки:		6. Транзистор полевой с двумя изолированными затворами обедненного типа с <i>P</i> -каналом с выводом от подложки	
а) обогащенного типа с <i>P</i> -каналом		7. Транзистор полевой с затвором Шоттки	
б) обогащенного типа с <i>N</i> -каналом		8. Транзистор полевой с двумя затворами Шоттки	
в) обедненного типа с <i>P</i> -каналом			
г) обедненного типа с <i>N</i> -каналом			

П р и м е ч а н и е. Допускается изображать корпус транзисторов.

10. Примеры построений обозначений фоточувствительных и излучающих полупроводниковых приборов приведены в табл. 9.

Т а б л и ц а 9

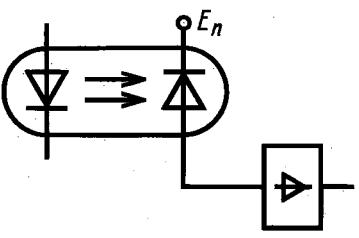
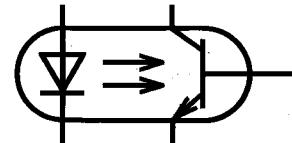
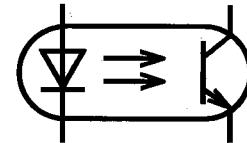
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Фоторезистор: а) общее обозначение		4. Фототранзистор: а) типа PNP	
б) дифференциальный		б) типа NPN	
2. Фотодиод		5. Фотоэлемент	
3. Фототиристор		6. Фотобатарея	

11. Примеры построения обозначений оптоэлектронных приборов приведены в табл. 10

Т а б л и ц а 10

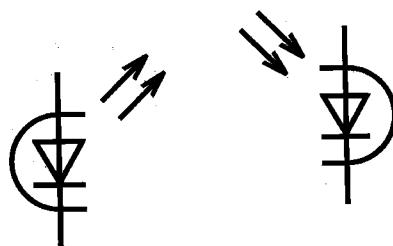
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
67 1. Оптрон диодный		4. Прибор оптоэлектронный с фотодиодом и усилителем: а) совмещенно	
2. Оптрон тиристорный			
3. Оптрон резисторный			

Продолжение табл. 10

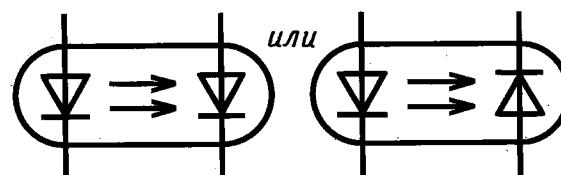
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
б) разнесенно		5. Прибор оптоэлектронный с фототранзистором: а) с выводом от базы	
		б) без вывода от базы	

П р и м е ч а н и я:

1. Допускается изображать оптоэлектронные приборы разнесенным способом. При этом знак оптического взаимодействия должен быть заменен знаками оптического излучения и поглощения по ГОСТ 2.721—74, например:

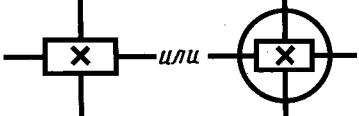
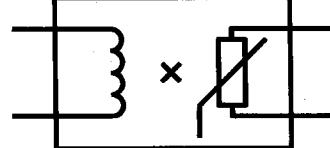
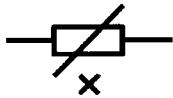


2. Взаимная ориентация обозначений источника и приемника не устанавливается, а определяется удобством вычерчивания схемы, например:



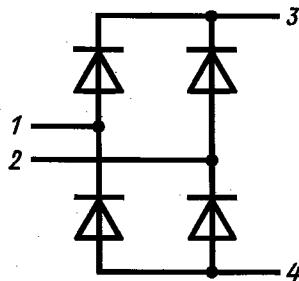
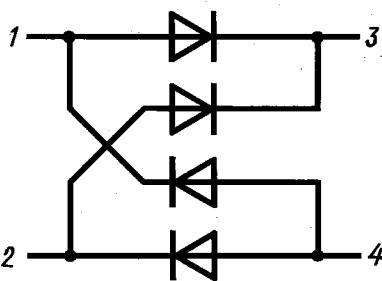
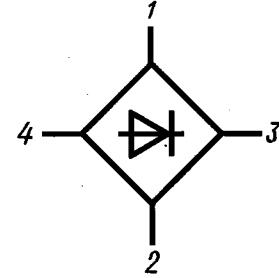
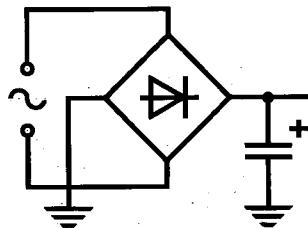
12. Примеры построения обозначений прочих полупроводниковых приборов приведены в табл. 11.

Таблица 11

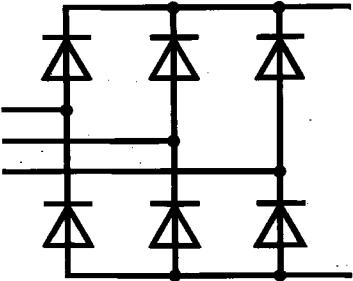
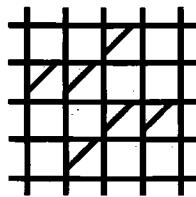
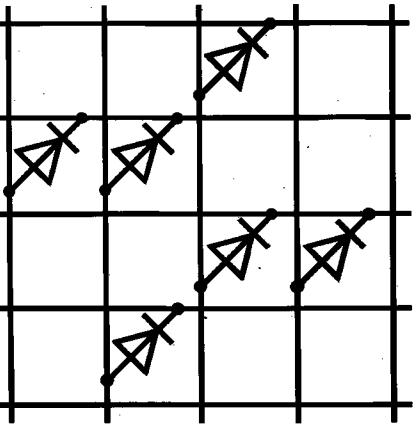
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Датчик Холла Токовые выводы датчика изображены линиями, отходящими от коротких сторон прямоугольника		3. Магнитный разветвитель	
2. Резистор магниточувствительный			

13. Примеры изображения типовых схем на полупроводниковых диодах приведены в табл. 12.

Таблица 12

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Однофазная мостовая выпрямительная схема: а) развернутое изображение	 <i>или</i> 	б) упрощенное изображение (условное графическое обозначение) П р и м е ч а н и е. К выводам 1–2 подключается напряжение переменного тока; выводы 3–4 — выпрямленное напряжение; вывод 3 имеет положительную полярность. Цифры 1, 2, 3 и 4 указаны для пояснения.	 

Продолжение табл. 12

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
2. Трехфазная мостовая выпрямительная схема		П р и м е ч а н и е . Если все диоды в узлах матрицы включены идентично, то допускается применять упрощенный способ изображения. При этом на схеме должны быть приведены пояснения о способе включения диодов	
3. Диодная матрица (фрагмент)			

14. Условные графические обозначения полупроводниковых приборов для схем, выполнение которых при помощи печатающих устройств ЭВМ предусмотрено стандартами Единой системы конструкторской документации, приведены в табл. 13.

Т а б л и ц а 13

Наименование	Обозначение	Отпечатанное обозначение	Наименование	Обозначение	Отпечатанное обозначение
1. Диод		---+>---	4. Транзистор типа <i>PNIP</i> с выводом от I-области		==== p --- --- : I --- --- *N --- --- p <---
2. Транзистор типа <i>PNP</i>		==== *N --- --- p --- --- : N --- --- p <---	5. Многоэмиттерный транзистор типа <i>NPN</i>		==== *N --- --- p --- --- : N --- --- N <---
3. Транзистор типа <i>NPN</i>		==== *P --- --- N --- --- : N --- --- N <---			==== *P --- --- N --- --- : N --- --- N <---

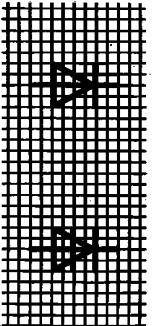
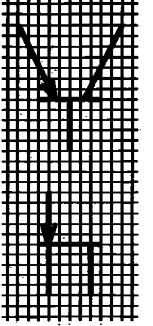
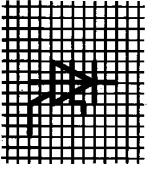
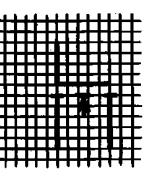
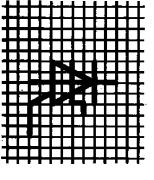
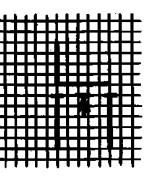
71

П р и м е ч а н и е к пп. 2—5. Звездочкой отмечают вывод базы, знаком «больше» или «меньше» — вывод эмиттера.

15. Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений даны в приложении 2.
(Измененная редакция, Иzm. № 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Исключено, Иzm. № 4).

Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Диод		4. Транзистор	
2. Тиристор диодный		5. Транзистор полевой	
3. Тиристор триодный		6. Транзистор полевой с изолированным затвором	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16.08.73 № 2002
3. Соответствует СТ СЭВ 661—88
4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.730—68, ГОСТ 2.747—68 в части пп. 33 и 34 таблицы
5. ИЗДАНИЕ (апрель 2010 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июле 1980 г., апреле 1987 г., марте 1989 г., июле 1991 г. (ИУС 10—80, 7—87, 6—89, 10—91), Поправкой (ИУС 3—91)